Резюме на решение на Комисията

от 19 май 2010 година

относно производство по член 101 от ДФЕС [1] и член 53 от Споразумението за ЕИП

(Дело COMP/38.511 — DRAMs)

(нотифицирано под номер C(2010) 3152 окончателен)

(Само текстовете на английски, немски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/C 180/09)

На 19 май 2010 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета [2] с настоящото Комисията публикува наименованията на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, взеимайки предвид законния интерес на предприятията относно опазването на търговските им тайни. Неоверителен вариант на решението може да бъде намерен на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

ВЪВЕДЕНИЕ

(1) Решението е адресирано до 10 предприятия и е свързано с единично и продължително нарушение на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

1.1. Процедура

(2) Настоящото дело беше открито, след като на 29 август 2002 г. Micron подаде заявление за освобождаване от глоби. През декември 2002 г. на Micron беше предоставено условно освобождаване от глоби. Между декември 2003 г. и февруари 2006 г. Infineon, Hynix, Samsung, Elpida и NEC подадоха заявления за освобождаване или намаляване на глоби до Комисията. Първото искане за информация беше изпратено през март 2003 г., а поредица от искания за информация бяха изпратени на по-късни дати.

(3) Процедурата за постигане на споразумение, която позволява на Комисията да решава случаи посредством опростена процедура, беше създадена през юни 2008 г. [3]. По това дело обсъжданията за постигане на споразумение започнаха през март 2009 г., след като дружествата заявиха, че са готови да участват в такива обсъждания. Впоследствие през декември 2009 г. всички те внесоха официални заявления за постигане на споразумение, в които ясно и недвусмислено признават съответната си отговорност за нарушението. На 8 февруари тази година на страните бе изпратено изложение на възраженията, отразяващо техните заявления, и всички страни потвърдиха, че неговото съдържание отразява техните заявления и че те продължават да са заинтересовани от процедурата за постигане на споразумение. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище на 7 май 2010 г., а Комисията прие решението на 19 май 2010 г.

1.2. Обобщение на нарушението

(4) Решението се отнася до единично и продължително нарушение в ЕИП на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП. Страните по нарушението са участвали в схема и/или мрежа за контакти и таен обмен на информация, чрез която са координирали своето поведение относно нивата на цените и котировките за основни производители на оригинално оборудване (ПОО) за персонални компютри/сървъри, което в крайна сметка е водело до координиране на цените спрямо такива клиенти. Това е правено с цел да се ограничи конкуренцията по отношение на основни ПОО за персонални компютри/сървъри с оглед на продажбите на динамична памет с произволен достъп DRAM (всички десет предприятия), а също и за продажбите на Rambus DRAM (само Toshiba, Samsung и Elpida), от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM.

1.3. Адресати и продължителност на нарушението

(5) Следните предприятия са нарушили член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП, като са участвали в посочените по-долу периоди в антикорупционно поведение,

---

[1] Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото решение препратките към членове 81 и 82 от Договора за ЕО следва да се разбират като препратки към членове 101 и 102 от ДФЕС, когато е уместно.

[2] ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1). Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото решение препратките към членове 81 и 82 от Договора за ЕО следва да се разбират като препратки към членове 101 и 102 от ДФЕС, когато е уместно.

[3] Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията от 30 юни 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели (ОВ L 171, 1.7.2008 г., стр. 3) и Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета при дела за картели (ОВ C 167, 2.7.2008 г., стр. 1—6).

водещо до координиране на цените спрямо основни ПОО на персонални компютри/сървъри съответно на DRAM и Rambus DRAM:

а) Micron Technology, Inc. от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

б) Micron Europe Limited от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

в) Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

г) Infineon Technologies AG от 14 ноември 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

д) Hynix Semiconductor Inc. от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

е) Hynix Semiconductor Europe Holding Ltd. от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

ж) Hynix Semiconductor Deutschland GmbH от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

з) Hynix Semiconductor United Kingdom, Ltd. от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

и) Samsung Electronics Co. Ltd. от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM);

й) Samsung Semiconductor Europe GmbH от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM);

к) Samsung Semiconductor Europe Ltd. от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM);

л) Samsung Semiconductor France Sarl от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM);

м) NEC Corporation от 1 юли 1998 г. до 28 февруари 2001 г. и непряко чрез Elpida от 1 март 2001 г. до 15 юни 2002 г.;

н) Renesas Electronics Europe GmbH (преди това NEC Electronics (Europe) GmbH до 1 април 2010 г.) от 1 юли 1998 г. до 28 февруари 2001 г.;

о) NEC Electronics (UK) Ltd. от 1 юли 1998 г. до 28 февруари 2001 г.;

п) Hitachi Ltd. от 9 ноември 1998 г. до 28 февруари 2001 г. и непряко чрез Elpida от 1 март 2001 г. до 15 юни 2002 г.;

р) Hitachi Europe Ltd. от 9 ноември 1998 г. до 28 февруари 2001 г.;

с) Mitsubishi Electric Corp. от 24 ноември 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

т) Mitsubishi Electric Europe BV от 24 ноември 1998 г. до 15 юни 2002 г.;

у) Toshiba Corp. от 1 юли 1998 г. до 22 април 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 22 април 2002 г. за Rambus DRAM);

ф) Toshiba Electronics Europe GmbH от 1 юли 1998 г. до 22 април 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 22 април 2002 г. за Rambus DRAM);

х) Elpida Memory Inc. от 1 март 2001 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM);

ц) Elpida Memory (Europe) GmbH от 1 март 2001 г. до 15 юни 2002 г. за DRAM (и от 9 април 2001 г. до 15 юни 2002 г. за Rambus DRAM); и

ч) Nanya Technology Corp. от 12 октомври 2001 г. до 15 юни 2002 г.

1.4. **Коригиращи мерки**

(6) С решението се прилагат насоките за глоби от 2006 г. ([1]). С изключение на Micron Technology, Inc., Micron Europe Limited и Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH, с решението се налагат глоби на всички дружества, изброени в точка 1.3 по-горе. В решението обаче не се вземат предвид продажбите на Rambus DRAM от Samsung при определянето на глобата, наложена на Samsung, както е посочено в съображение (13) по-долу.

1.4.1. *Основен размер на глобата*

(7) Основният размер на глобата е определен на 16 % от стойността на продажбите на предприятията на DRAM (включващи и Rambus DRAM, когато е приложимо) ([2]) на основни ПОО за персонални компютри/сървъри в ЕИП.

([1]) ОВ C 210, 1.9.2006 г., стр. 2.

([2]) За да бъде изчислена глобата, която да се наложи на Micron, Hynix, Infineon, Mitsubishi и Nanya, беше взета предвид само стойността на продажбите на DRAM, с изключение на Rambus DRAM, ако е имало такива. Освен това, както вече беше споменато, продажбите на Samsung на Rambus DRAM не са взети предвид при изчисляването на глобата, която да бъде наложена на Samsung.

(8) Основният размер се умножава по броя на годините на участие в нарушението, така че да се отчете напълно продължителността на участието на всяко предприятие в нарушението поотделно.

1.4.2. *Корекции на основния размер*

1.4.2.1. Утежняващи обстоятелства

(9) По настоящото дело няма утежняващи обстоятелства.

1.4.2.2. Смекчаващи обстоятелства

(10) Поради наличието на смекчаващи вината обстоятелства глобите на три (от десет) предприятия бяха намалени. Предприятието Hynix получи намаление от 5 % в резултат на много специфичните обстоятелства, в които се е намирало през 2001 г. ([1]). Предприятията Toshiba и Mitsubishi получиха намаление от 10 % за всяко от тях, тъй като участието им е било значително по-ограничено от това на другите доставчици през съответния период.

1.4.2.3. Специално увеличение с възпираща цел

(11) Въз основа на големината на засегнатите предприятия е целесъобразно да се приложи мултипликационен коефициент за наложената глоба. На тази основа глобата за Hitachi се умножава по 1,2, а глобата за Samsung и Toshiba се умножава по 1,1.

1.4.3. *Прилагане на ограничението за 10 % от оборота*

(12) В настоящото дело не се изисква адаптиране на сумите спрямо оборота на предприятията.

1.4.4. *Прилагане на Известието от 2002 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер*

(13) Micron е освободен от глоби, за Infineon глобата се намалява с 45 %, за Hynix глобата се намалява с 27 %, а за Samsung, Elpida и NEC глобата се намалява с 18 % за всяко предприятие. Освен това Samsung се освобождава „de facto“ от глоби по отношение на Rambus DRAM в допълнение към намалението, отредено в рамките на неговата група, получила снизходителност във връзка с DRAM.

2. **ГЛОБИ, НАЛОЖЕНИ С РЕШЕНИЕТО**

(14) За разгледаното с настоящото решение единично и продължително нарушение се налагат следните глоби:

а) солидарно на Micron Technology Inc., Micron Europe Limited и Micron Semiconductor (Deutschland) GmbH: 0 EUR;

б) на Infineon Technology AG: 56 700 000 EUR;

в) солидарно на Hynix Semiconductor Inc., Hynix Semiconductor Europe Holding Ltd., Hynix Semiconductor Deutschland GmbH и Hynix Semiconductor United Kingdom, Ltd: 51 471 000 EUR;

г) солидарно на Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Semiconductor Europe GmbH, Samsung Semiconductor Europe Ltd. и Samsung Semiconductor France Sarl: 145 728 000 EUR;

д) солидарно на NEC Corporation, Renesas Electronics Europe GmbH (преди това NEC Electronics (Europe) GmbH до 1 април 2010 г.) и NEC Electronics (UK) Ltd.: 10 296 000 EUR;

е) солидарно на Hitachi Ltd. и Hitachi Europe Ltd.: 20 412 000 EUR;

ж) солидарно на Mitsubishi Electric Corp. и Mitsubishi Electric Europe BV: 16 605 000 EUR;

з) солидарно на Toshiba Corp. и Toshiba Electronics Europe GmbH: 17 641 800 EUR;

и) солидарно на Elpida Memory, Inc. и Elpida Memory (Europe) GmbH, NEC Corporation и Hitachi Ltd.: 8 496 000 EUR;

й) на Nanya Technology Corp.: 1 800 000 EUR; и

к) солидарно на NEC Corporation и Hitachi Ltd.: 2 124 000 EUR.

([1]) Както е установено в по-ранни производства на Комисията относно антисубсидиите в ЕС, да се направи позоваване на Регламент (ЕО) № 708/2003 на Комисията от 23 април 2003 г., параграф 148 и следващи, потвърден с Регламент (ЕО) № 1408/2003 на Комисията от 11 август 2003 г.